

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
28. April 2005 (28.04.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/038930 A2**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **H01L 29/786**,  
21/336, B81C 1/00, H01L 21/308

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP2004/052333**

(22) Internationales Anmeldedatum:  
28. September 2004 (28.09.2004)

(25) Einreichungssprache: **Deutsch**

(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**

(30) Angaben zur Priorität:  
10348007.2 15. Oktober 2003 (15.10.2003) **DE**

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): **INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]**; St.-  
Martin-Str. 53, 81669 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **TEWS, Helmut**  
[DE/DE]; Frankenwaldstr. 36, 81549 München (DE).  
**FEHLHABER, Rodger [DE/DE]**; Lautensackstr. 24,  
80687 München (DE).

(74) Anwälte: **KINDERMANN, Peter** usw.; Patentanwälte  
Kindermann, Postfach 1330, 85627 Grasbrunn (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,  
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,  
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,  
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,  
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,  
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,  
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,  
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,  
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,  
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,  
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,  
TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,  
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT,  
RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,  
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

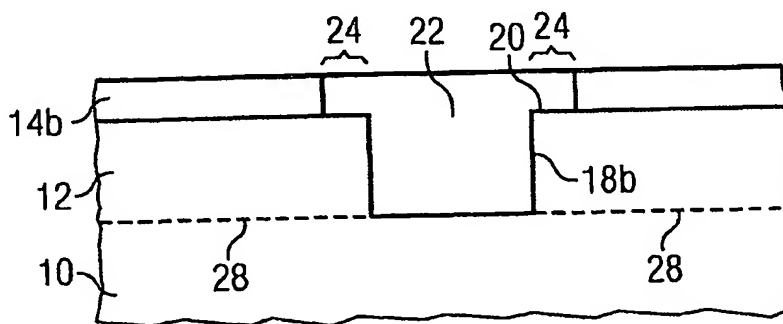
**Veröffentlicht:**

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu ver-  
öffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-  
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-  
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der  
PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: **STRUCTURING METHOD, AND FIELD EFFECT TRANSISTORS**

(54) Bezeichnung: **VERFAHREN ZUM STRUKTURIEREN UND FELDEFFEKTTTRANSISTOREN**



(57) Abstract: Disclosed is a structuring method, among other things. According to said method, a filling material (22) having a T-shaped cross section is used as a structuring mask in order to create structures with sublithographic dimensions, particularly a double-fin field effect transistor.

(57) Zusammenfassung: Erläutert wird unter anderem ein Verfahren zum Strukturieren, bei dem ein Füllmaterial (22) mit T-förmigem Querschnitt als Maske beim Strukturieren verwendet wird, um Strukturen mit sublithografischen Abmessungen zu erzeugen, insbesondere einen Doppel-Finnen-Feldeffekttransistor.

WO 2005/038930 A2